



MD 1270 Y 2018.07.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **1270** (13) **Y**
(51) Int.Cl: *G01R 31/26* (2006.01)
G01R 31/27 (2006.01)
B82Y 35/00 (2011.01)

(12) BREVET DE INVENȚIE
DE SCURTĂ DURATĂ

În termen de 6 luni de la data publicării mențiunii privind hotărârea de acordare a brevetului de invenție de scurtă durată, orice persoană poate face opoziție la acordarea brevetului	
(21) Nr. depozit: s 2017 0138 (22) Data depozit: 2017.12.27	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2018.07.31, BOPI nr. 7/2018
(71) Solicitant: UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD (72) Inventatori: VERJBIȚKI Valeri, MD; LUPAN Oleg, MD; RAILEAN Serghei, MD (73) Titular: UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD	

(54) Dispozitiv de măsurare a parametrilor sensorului pe bază de oxizi semiconductori nanostructurați în diapazon de ordinul microwaților

(57) Rezumat:

1
Invenția se referă la domeniul tehnicii de măsurare și poate fi utilizată în aparate de măsurat, în care se utilizează senzori pe bază de oxizi semiconductori nanostructurați.

Dispozitivul de măsurare a parametrilor sensorului pe bază de oxizi semiconductori nanostructurați în diapazon de ordinul microwaților include o sursă de tensiune de referință reglabilă, conectată în serie cu un senzor cercetat și o rezistență etalon, căderea totală a tensiunii pe senzor și rezistența etalon

2
și, separat, căderea de tensiune pe rezistența etalon fiind aplicate la intrările a două convertoare analogic-digitale ale unui microcontroler prin două amplificatoare operaționale, ieșirile microcontrolerului sunt conectate print-un convertor digital-analogic la intrarea sursei de tensiune de referință reglabilă și la un ecran pentru afișarea rezultatelor obținute.

Revendicări: 1
Figuri: 2

MD 1270 Y 2018.07.31